

B11

바이어스전압 인가가 NiFe 박막의 자기적 특성에 미치는 영향

삼성종합기술원 김정훈*, 김효상
이재욱, 김홍식, 김인웅

Effect of Induced Bias Voltage on Magnetic Properties of Permalloy Thin Films

Samsung Advanced Institute of Technology
J.H.Kim*, H.S.Kim, J.W.Lee, H.S.Kim, I.E.Kim

1. 서론

최근 Ferromagnetic 박막을 이용한 박막자기 Head는 고밀도 자기기록의 기술 발전에 따라 많은 관심을 끄는 분야이다. 특히, 기록된 정보의 재생에 사용되는 자기저항형 (Magnetoresistive, 이하 MR) 박막 Head의 주요 부위인 Permalloy 박막에 대한 많은 연구가 진행되고 있다.

MR 재생 Head에서 Flux Guide 용 NiFe 박막은 Media로 부터의 신호를 MR Sensor로 유도하는 부위로 그 자기적 특성과 Domain 형상은 MR 재생 Head의 특성에 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

본고에서는 바이어스전압 인가에 따른 제조박막의 조성 및 자기적특성을 측정한 후, Dry Etching 을 이용하여 Patterning 하여 Domain 형상을 고찰하였다.

2. 실험 방법

NiFe 박막은 R.F.Magnetron Sputtering 방식으로 두께 0.8 μm 으로 제조하였다. 기판은 Corning 7059 Glass를 사용하였고, NiFe 박막에 자기적 이방성을 부여하기 위하여 Film Plane 과 평행한 방향으로 Field 를 인가하였다. 제조박막의 자기적 특성 평가를 위하여 VSM 및 투자율 측정 장치를 사용하였고, 자체 제작한 자외 측정 장치를 이용하여 자외를 측정하였다. 이후, Photolithography 를 이용하여 제조 박막에 Pattern을 형성한 후 Domain 구조와 자기적 특성간의 관계를 고찰하였다.

3. 실험결과 및 고찰

바이어스전압 인가에 따른 자외의 변화를 Fig.1 에 나타내었다. 바이어스전압이 증가함에 따라 자외는 (+) 방향으로 거의 직선적으로 증가하였다. Table 1 은 81Ni19Fe wt% 조성의 NiFe Target 으로 바이어스전압 인가에 따라 제조한 박막의 ICP 분석 결과를 나타낸 것이다. 바이어스전압이 증가함에 따라 Ni 의 함량이 감소함을 알 수 있으며, 이는 바이어스전압에 의해 제조시 박막내의 Ni 성분이 Fe 성분 보다 Resputtering 의 용이함에 기인한다고 생각된다. Fig.2 는 바이어스전압 인가에 따른 투자율의 변화를 나타낸 것이다. 바이어스전압이 -60 Volt 까지 증가함에 따라 투자율은 증가한후 감소함을 알 수 있다. Fig.3 은 바이어스전압 인가에 따른 Domain 구조 변화를 나타낸 것이다. 바이어스전압의 변화에 따라 제조박막에 유입되는 Stress 변화 및 자외 변화의 상호작용이 투자율 및 Domain 의 형상에 영향을 미치는 것으로 생각된다.

Table 1 Dependence of the composition on the bias voltage

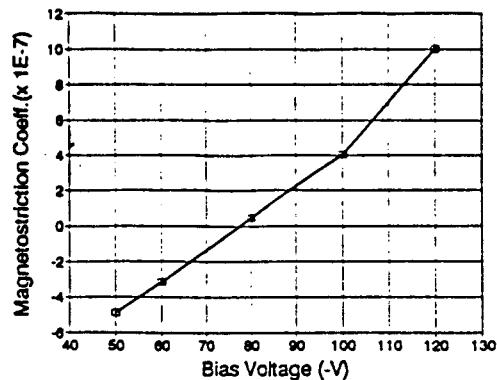


Fig.1 Dependence of the magnetostriction on the bias voltage

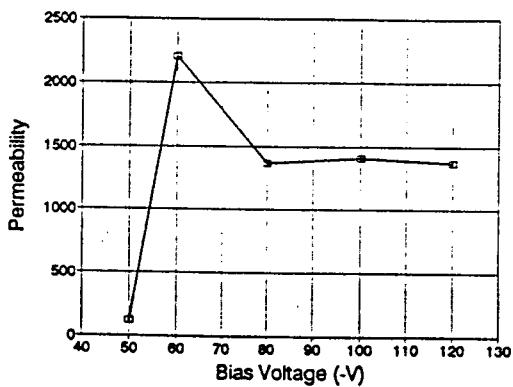


Fig.2 Dependence of the permeability on bias voltage (at 10 MHz)

실험 조건	Ni (wt%)	Fe (wt%)
Target	81.3	18.7
Vbias = 0 V	80.9	19.1
Vbias = -100 V	81.2	18.8
Vbias = -200 V	79.9	20.1

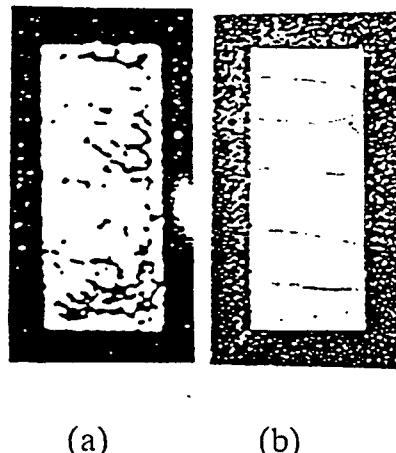


Fig.3 Bitter Patterns of domain structures in:
 (a) $V_b = -60$ Volt
 (b) $V_b = -100$ Volt

4. 결론

MR 재생 Head 의 Flux Guide 용 RF Magnetron Sputtered NiFe 박막을 제조할 경우, 바이어스전압 인가는 조성, 투자율, Stress 그리고 자외에 영향을 미치며, 자외가 zero 근처 (-) 부근에서 양호한 자기적 특성을 나타내는 Domain 구조를 갖는다.

5. 참고문헌

- ① Kenji Komaki, J.Electrochem.Soc.,140 2 529 (1993)
- ② Y.Shiroishi et al., IEEE Trans.Magn.,Mag-20 3 485 (1984)